Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-233194(43)Date of publication of application: 21.08.1992

(51)Int.Cl. H05B 33/22 H01L 29/28 H01L 33/00 H05B 33/26 // C09K 11/00 C09K 11/06

(21)Application number: 03-184376 (71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing: 24.07.1991 (72)Inventor: LITTMAN JON E

SCOZZAFAVA MICHAEL

(30)Priority

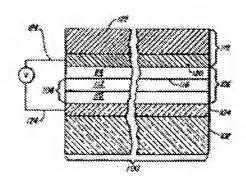
Priority number: 90 557847 Priority date: 26.07.1990 Priority country: US

### (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE HAVING STABILIZED CATHODE CAP LAYER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an organic electroluminescent device to be protected from dark spot formation.

CONSTITUTION: An organic electroluminescent device is provided forming a base, an anode, an organic electroluminescent medium and a cathode, containing several kinds of metal other than alkali metal, in this order. The cathode is inserted between a cap layer, containing at least either alkaline earth metal or rare earth metal, and the organic electroluminescent medium. In this cathode, at least one kind of metal has a work function of less than 4.0, and an electron injection layer is provided containing metal having a higher work function than alkaline earth metal or rare earth metal.



## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顯公開番号

# 特開平4-233194

(43)公開日 平成4年(1992)8月21日

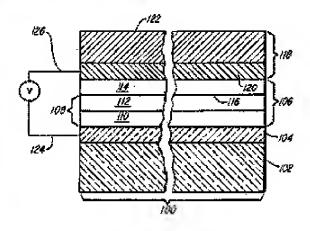
| (51) Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 5 B 33/22 H 0 1 L 29/28 33/00 |              | 庁内整理番号<br>8815-3K<br>8728-4M<br>8934-4M | F 1      | 技術表示管所  |
|---|--------------|---|----------|---|
| H05B 33/26  | 10           | 8815 – 3K<br>6917 – 4H                  |          |   |
| # C09K 11/09  | r            | ρ <u>9</u> [1 — ∉[2]                    | 容置無求 未請求 | ☆ 請求項の数 1〈全 12 頁) 最終頁に続く  |
| (21)出顯番号  | 特願平3-184376  |   | (71)出頭人  | 590000846<br>イーストマン コダツク カンパニー  |
| (22) 出頭目  | 平成3年(1991)7月 | ∄24 <b>日</b>                            |          | アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ<br>テエスター, ステイト ストリート343                         |
| (31)優先權主張番号<br>(32)優免日<br>(33)優先權主張国                        | 1990年7月26日   |   | (72) 発明者 | ジヨン エリツク リツトマン<br>アメリカ合衆国, ニューヨーク 14472,<br>ハノイ フオールズ, プレインズ ロード<br>205 |
|   |              |   | (72) 発明希 | マイケル スコツザフアバ<br>アメリカ合衆国、ニューヨーク 14613,<br>ロテエスター、セネカ パークウエイ<br>740       |
|   |              |   | (74)代理人  | 弁理士 背木 蝟 (外4名)  |

## (54) 【発明の名称】 安定化カソードキャップ層を有する有機エレクトロルミネセンス装置

# (57) 【萎約】

(目的) ダークスポット形成から保護される布機エレクトロルミネセンス装置を提供する。

【構成】 基板と、アノードと、有機エレクトロルミネセンス媒体とアルカリ金属以外の複数の金属を含むカソードとを順次散けてなる有機エレクトロルミネセンス競響を提供する。前記カソードはキャップ層と有機エレクトロルミネセンス媒体との間に挿入された、アルカリ土類金属又は希土類金属少なくとも1種を含有するキャップ層と、少なくとも1種の金属が4、0未満の仕事関数を有するが、キャップ層のアルカリ土類金属又は希土類金属より高い仕事関数を示す金属を含有する電子注入層からなる。



特開平4-233194

I

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基級と、アノードと、有機エレクトロルミネセンス媒体とアルカリ金属以外の複数の金属を含むカソードとを設けてなる有機エレクトロルミネセンス装置において、前記カソード層が少なくとも1種のアルカリ土類金属又は希土類金属を含んでおり、そして前配キャップ層と前記有機エレクトロルミネセンス媒体間に、仕事関数4.0未満を属するが前記キャップ層のアルカリ土類金属または希土類金属よりも大きい仕事関数を示す少なくとも1種の金属を含む電子並入層が挿入されて 10 いることを特徴とする有機エレクトロルミネセンス装置、

#### 【発明の詳細な説明】

 $\{0\ 0\ 0\ 1\}$ 

【選業上の利用分野】本発明は、布機エレクトロルミネ センス装置に関する。より詳細には、本発明は、導電性 育機層から発光する装置に関する。

#### [0 0 0 2]

【従来の技術】エレクトロルミネセンス装置(以下、「B L 装置」とも称する)には、電極がエレクトロルミネセンス媒体により分離され間隔をあけた状態で含まれているが、このエレクトロルミネセンス媒体は、電極間に印加した電位差に応答して電磁放射線、典型的には光を発する。このエレクトロルミネセンス媒体は、ただ単に発光することができなければならないばかりでなく連続状に作製できなければならず(即ち、ピンホールがあってはならない)、そして容易に作製されるとともに装置の動作に耐えるに十分な程度に安定でなければならない。

【0003】 従来の有機EL装置の代表例として、メー 30 ル等(Mehl et al)による米国特許第3,5 30,325号、ウイリアムズ(Willlams)による米国特許第3,621,321号、タング(Tang)による米国特許第4,356,429号、バンスリーケ等(VanSlyke et al)による米国特計第4,539,507号及び第4,720,432号並びにタング等による米国特許第4,769,292号及び第4,885,211号が維げられる。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、有機 40 比し装置におけるダークスポットの出現を減少させることである。本発明のさらなる目的は、薄膜蒸着法による 形成と適合するカソード特性が向上した有機已し装置を 提供することである。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の一線様によれば、基級と、アノードと、有機エレクトロルミネセンス 媒体と、アルカリ金属以外の複数の金属から実質的になるカソードとを順次設けてなる有機エレクトロルミネセンス製質が提供される。この装置は、前記カソードが、 少なくとも1種のアルカリ主類金属又は希主類金属を含むキャップ属と、そのキャップ属と有機エレクトロルミネセンス媒体間に増入されており、仕事関数が4.0未満であるが前記キャップ層のアルカリ土類金属又は希土類金属よりも高い仕事関数を示す金属少なくとも1種を

含む電子注入層とからなることを特徴とする。

【0006】有機エレクトロルミネセンス(EL)装置 100を第1圏に示す。このEL装置は、光透過低アノード104を上に塗布した光遥過性基板102から構成されている。アノードの上には、有機エレクトロルミネセンス媒体106が設けられている。圏示されているように、有機エレクトロルミネセンス媒体は、(1)正孔注入・輸送帯域108と、(2)正孔輸送層と接合116を形成している電子注入・輸送帯域114とに分けられる。正孔注入、輸送帯域108は、さらに、(a)アノードと複触している正孔注入階110と(b)その上に設けた正孔輸送層112とに分けられる。

【9007】電子注入暦120とキャップ層122とからなるカソード118は、有機エレクトロルミネセンス 媒体の上に設けられている。電子注入暦は、有機エレクトロルミネセンス 内ロルミネセンス媒体上に位置する。使用に際して、ア ノード104とカソード118とを、それぞれ導体12 4と126とにより外部電源Vに接続する。電源は、連 統直流若しくは交流電流電圧源であっても、断統電流電 圧源であってもよい。適当なスイッチ回路を含んでいる カソードに対してアノードを正にパイアスできる適当な 通常の電源を用いることができる。アノードかカソード は、大速電位であることができる。

【0008】有機EL装置は、アノードがカソードより も電位が高いときに順方向にパイアスされるダイオード とみなすことができる。これらの条件下で、正孔が、ア ノードから正乳注入・輸送帯域106の正孔注入層11 0に注入される。正乳は、正乳輸送階112と接合11 6を介して、電子注入・輸送帯域1.14に輸送される。 問時に、カソード118から電子注入・輸送構織114 に電子が注入される。正孔を充填する際に、移動電子が 伝導帯電位から価電子帯に降下するとき、エネルギーが 光として放出される。別の構成を選択して、放出された 光を、重極を分離している有機エレクトロルミネセンス 媒体の一つ以上の端を介するか、アノードと基板を介す るか、カソードを介するか、上記の組み合わせを介して 放射することができる。有機エレクトロルミネセンス媒 **体がかなり薄いので、通常、2つの電極のうちの一つを** 介して光を放射することが好ましい。図示されている好 ましい形態のEL装置では、アノードと基板を、とりわ け、光透過微となるように構成することにより、これら の要素を介して放射を容易にする。

【0009】電極の逆方向バイアスにより、可動電荷移 動方向が逆になり、客機エレクトロルミネセンス媒体の 50 可動電荷キャリヤーが複い尽くされ、そして光の放射が

終了する。AC電源を用いると、EL核圏の内部接合 が、各周期の一部分で順方向にパイアスされ、そして周 期の残りの部分で逆にバイアスされる。

【0010】育機EL装置を効率的に動作させるため に、カソードは、有機エレクトロルミネセンス媒体と後 触した状態で比較的低い(4,0 e V 未満) 仕事関数を 育する少なくとも一種の金属を含含しなければならな い。したがって、カソードの界面に存在する最も低い他 事闘数の金属は、特に酸化されやすい。有機足し装置装 置を取り着いている周囲雰囲気中に湿分があると、低仕 20 又は希土類金属より低い仕事関数)の金属より高い仕事 事関数の金属が限定された量でしか存在しないか、もっ と高い仕事関数の金属をオーバーコートした場合であっ でも、カソードの低仕事関数金属と有機エレクトロルミ ネセンス媒体との界面で酸化が坐じることが観察され Ta.

【0011】カソードの酸化され易さは、効率的な有機 DL装置のカソードの材料と操作に固省のものであるの で、さらなる寄与因子がある。薄膜形成法により有機回 L装置を構成する際には、ミクロチャンネル(頻緻袋的 局部破壊)がカソードに存在し、カソードを通して温分 を複機エレクトロルミネセンス媒体との界面に移動させ るものと思われる。

【0012】本発明は、高レベルの効率と周囲很分の存 征下での有機EL装置からの光の放射の均一性の改善の 両方が遠応される(即ち、長時間にわたってダークスポ ットの出現が減少される) 有機EL装置のカソード構成 の発見に基づくものである。少なくとも一種の金属成分 の仕事関数が低い(<4、0eV)仕事関数(値し、使 用するには不安定すぎるアルカリ金属を除くことは勿論 である)の金属混合物からなるカソードを用いることに おり より、高レベルの効率が離成される。この点に関して、 本発明は、上記したタング等による米國祭評第4、88 5、211号(引用することにより本明組書の内容とな る)の数示事項を満たすものであるが、低い仕事関数の 金属はカソードの電子接入層の少量以上を超えて存在す る必要がないという極めて重要な差異がある。好ましい カソード電子注入層は、低い仕事関数の金属を少なくと も0.05%(好ましくは少なくとも0.10%)含. む。(本明編書で用いるすべての%は、特記しないかぎ り総重量基準の重量%である。)カソード電子注入層に おいて高い (>4.0eV) 仕事関数の金属又は金属類 は、いずれか都合のよい濃度で使用できる。高い仕事関 数の金属はカソード電子注入層に1%程度の少量とみな せる場合に堆積の利益が認められるが、この層の高い社 事関数の金属濃度は少なくとも2%が好ましい。高い仕 事関数の会属は低い仕事関数の金属を提供することなく 震子注入層の全量を占めてもよいが、80%を越え、さ らに90%を越える高い仕事関数の金属濃度ですら具体 的には使用できる。

【0013】周囲温分の存在下での発光の均一後を改良 *50* **る。例えば、藩譲準積法を使用すると、約20ヵmまで** 

するには、カソードはキャップ層を確える。仕事関数約 4.256Vのアルミニウムからなるキャップ層は、ダ ークスポットの低減に無効であることが示されてきた。 **岡様に、高機エレクトロルミネセンス媒体を調製するの** に使用されるような有機材料のキャップ層もまた、ダー クスポットの低減に無効であることが示されてきた。

【0014】まったく驚くべきことに、低い(<4.0 e V)低事関数を有するが、キャップ層のもっとも低い **仕事関数(即ち、キャップ層のアルカリ土類金属及び/** 関数を有する少なくとも1種の金属を含む電子注入層と **減め合わせて使用される、アルカリ土類金属及び/又は** 希土類金属を含むキャップ層を担持するカソードの構成 は、翌分の存在下で出現するダークスポットから有機区 し装置を保護することが発見された。カソードの構成に カソードの電子注入層におけるもっとも低い仕事関数の 金属よりも低い仕事関数の1種以上の金属を加えること が装置の安定性を高めることは意外である。アルカリ土 類金属及び発土類金属は、普通にカソードの構成に用い 20 られている金属とほとんどの場合にはアルカリ金属の住 事関数との中間にある仕事関数を有するので、カソード の構成へのアルカリ土類金属及び/又は希土類金属の縁 加は独置の安定性を損ねるものと考えることが合理的で あろう。

【0015】少なくとも1種のアルカリ土類金属又は/ 希主類金属を含むカソードキャップ層は、カソード電子 進入層と主としてダークスポットに応答する有機エレク トロルミネセンス媒体との界面で酸化され、その界面が ら離れたカソード部であまり酸化されないので、ダーケ スポットの形成を低減するのに有効であると信じられ శే.,

【0016】アルカリ土類会属又は希土類金属を有機工 レクトロルミネセンス媒体と直接触させることなくキャ ップ暦に限定することで、アルカリ土類金属又は治土類 金属は、個分と反応するか、またカソードと省機エレク トロルミネセンス媒体との界面に達する週分を捕捉する ように配置される。アルカリ土積金属又は希土積金属の 酸化は装置の効率を損わない。なぜかならば、装置の効 率を制御するのは有機エレクトロルミネセンス媒体と接 触しているもっとも低い仕事関数の金属であるからであ る。同様に、酸化部位は有機エレクトロルミネセンス봻 体を育する電子注入界面から離れているので、アルカリ 土類金属又は希土類金属の酸化はダークスポットを促進 しない。

【0017】ダークスポットの低減を効果あらしめるに は、キャップ層の、厚さは少なくとも500オングスト ローム(好ましくは少なくとも1000オングストロー ム、最適には少なくとも2000オングストローム)で ある。いずれか獨合のよいキャップ層の厚さが砂用でき

の厚さのキャップ層を容易に作製できる。一般的に、本 発明の完全な利点は、キャップ層の厚さが少なくともも μmである場合に認められ、最大の溶融金属競子の層の。 厚さが約2μmであることが好ましい。

【0018】上述したキャップ層の厚さは、キャップ層 の少なくとも80%、好ましくは少なくとも90%がア ルカリ土類金属と衛土類金属の1種又は組み合わせが占 めるものと仮定して予測されている。一般的に、キャッ プ暦は実質的にアルカリ土類金属と希土類金属の1種又 は組み合わせからなることが好ましい。しかしながら、 少量の他の材料1種以上の存在が用いられる層形成法に 応じてキャップ層の形成を促進するのに有利である可能 性があることも認識されている。

【0018】特に好ましい態様では、カソードの電子注 入層はタング等の米国特許第4,885,211号の契 **体を燗たすカソードのいずれかと同一でありうる。特** に、タング等の米国特許第4、885、211号のM g:Agカソードは、好ましい電子注入層構造の一つで あるが、タング等が示唆するように、マグネシウムは3 内で存在しうる。

【0020】もう一つの好ましい態様では、カソード電 子注入層はアルミニウムとマグネシウムから構成するこ とができる。アルミニウム・マグネシウムカソードの形 盤は、上記した米国特許出願と同時に出願されたバンス リケ(VanSlyke)等(1)の主題であり、この 発明のカソード電子並入層はそのような構成をとること ができる。

【0021】上述の好ましいカソード電子往入層構成物 では、マグネシウムが使用されるが、それを仕事関数 30 3. 9 e V ~ 3. 5 e V の他の金属で置き換えることが できる。この仕事関数の範囲内の金属のうちでは、ベリ リウム、マグネシウム、ガリウム、インジウム、ハフニ ウム及びテルルが特に好ましい。これらの金属の1種又 は組み合わせのいずれかを、マグネシウムに代えて又は マグネシウム網み合わせて使用することができる。

【0022】カソードキャップ層は、いずれか適当なア ルカリ土類金属又は希土類金属あるいはこれらの金属の 組み合わせであって、前記カソード電子注入層における いずれの金属の仕事関数より小さいそれを有するように 40 **選ばれた金属を提供する。例えば、もっとも低い仕事関** 数の金属が4、0eV~3、5eVの範圍内にあるとき には、キャップ層には希土類金属のいずれかを存在させ る。なぜかならば、すべての希土類金属は、3、5 e V より小さい仕事関数を育するからである。本明細書で使 用する「希土類(rare earth)」の語は、第 3 族金属、スカンジウム、イットリウムおよびランタニ ド系列の元素を称する。

【0023】アルカリ土類食風のすべては、ベリリウム とマグネシウムを除き3.0eVより小さい仕事関数を 50 の50%を超える量を透過することを意味する。鏡間

有する。従って、ベリリウム又はマグネシウムは、絶み 合わせて使用される他の金属叉は金属類に応じて、電子 注入層又はキャップ層のいずれかで使用できることは明 らかである。しかしながら、ペリリウムは仕事関数3. 9 e Vを有するのでより大きい仕事関数を有する金属は **乾鮫的少ないが、まだ4.0eV未満であるので、ベリ** リウムをキャップ層に配置することを再能にする組み合 わせにおいては使用できる。他方、上述した好変しいM 8含有電子注入層は、提供されるアルカリ土類金属及び 10 希土類金属の少なくとも1種がマグネシウムでないいず れかのアルカリ土類金属及び/又は希土類金属を含有す。 るキャップ層と組み合わせて使用できる。逆に、電子独 入層がそのもっとも低い仕事関数の元素として、例えば マグネシウムより高い仕事関数を育するイリジウム、ガ リウム又はインジウムを含む場合には、キャップ層にマ グネシウムを用いることにより本発明の利点は認めるこ とができる。

【0024】稻土類元素は次の2種の範疇に分けること ができる。即ち、(1) 仕事関数3.0~3.5eVを **0%より大きい濃度であるよりも、むしろ上述した韓國 20 有するもの、例えば、スカンジウム、イットリウム、ラ** ンタン、ネオジム、サマリウム、ガドリニウム、テルビ ウム、ジスプロシウム、エルピウム、ホルミウム、ツリ ウム及びルテチウム、並びに(2)仕事関数2.5~ 3. 0 e V を有するもの、例えば、セリウム、プラセオ ジム、ユーロピウム及びイッテルビウムである。(1) の統略の希土類をカソード注入層に配置し、同時に (2) の輪疇の希土類をキャップ層に配置することがで きる.

> 【0028】キャップ層に配置すべきもっとも低い仕事 関数の金属を選ぶ一方、カソード注入層に配置すべきよ り高い仕事関数の金属を選ぶことによってさらに別の組 み合わせも可能であることは明らかであるが、1種は 4.0 e V未満の仕事関数を有するものである。

【0026】有機EL装置装置のアノードは、いずれか の通常の形態をとることができる。典型的には、アノー ドは、仕事関数が4.06Vを超える一種の金属又は二 種以上の金属の組み合わせから構成される。仕事関数が 4. 0eVを超える金属は、タング等による米国特許第 4,885,211号に列挙されており、これは引用す ることによって本明細書の内容となっている。ルミネセ ンスがアノードを介して生じることが好ましいときに は、アノードを、酸化インジウム、酸化銹又は最適には 酸化インジウム錫(ITO)等の一種又は複数の光透過 任金属酸化物の組み合わせから構成することが好まし

【0027】本明細書で用いられる用器「光透過億(1 ight transmissive)」とは、単純 に、記載する層又は要素が、それが好ましくは少なくと も100mmの間隔で受ける少なくとも一つの液長の光

(非散乱) 発光と拡散(散乱) 発光の両方が望ましい複 置出力であるので、半透明材料と透明材料(又は実質的 に透明な材料)の両方が有効である。また、ほとんどの 場合、有機EL製置の光透過層又は要素は、無色である か中性の光学濃度を有し、即ち、一つの層が別の層と比 酸して、一つの放長において暫しく高い光吸収を示すこ とはない。しかしながら、光透過性電極基板又は別個に 重量するフィルム者しくは要素は、必要に応じて、発光 トリミングフィルムとして作用するように光吸収性を調 整できることは勿論である。このような電極構成につい が ては、例えば、フレミング(Fleming)による来 国特許第4、035、686号に公表されている。電極 の光透過性導電層は、受ける光の波長又は波長の倍数に 近似した厚さに作製されている場合には、干渉フィルタ 一として作用することができる。

【0028】有機エレクトロルミネセンス媒体は、タングによる米国特許第4,856,429号、パンスリケ等による米国特許第4,539,507号、タング等による米国特許第4,769,292号及び第4,885,211号に公安されている有機をし装置の有機エレクトロルミネセンス媒体を形成するものとして教示されている有機材料のいずれか一種または額み合わせから選択することができる。これらの特許に公安されている事柄は、引用により本明観書の内容となる。最も有利な構成は装置100に関連して上記で説明した帯域と層を用いたものであるけれども、有機エレクトロルミネセンス媒体はユニタリー層であることができる。

【0029】高レベルの有機EL装置効率を避成するた めには、有機エレクトロルミネセンス媒体を、少なくと も2種の異なる帯域、即ち、電子性入・輸送帯域(典型 30 的には第一層)と正孔注入・輸送器域とから構成するの が好ましい。正孔注入・輸送層は単一層として構成でき るが、正乳注入圏と正乳輸送圏とから構成するのが最も 効率的である。本発明の好ましい態様においては、ボル フィリン系化合物を含有する層が、内部接合有機BL装 置の正孔注入層を構成する。ボルフィリン系化合物は、 ポルフィリン構造に由来するかポルフィリン構造を含ん だいずれの化合物でもよく、天然でも合成でもよい。ア ルダー等(Alder etal)による米国特許第 3,935,031号やタングによる米国特許第4,3 40 56、429号に公表されているいずれのポルフィリン 系化合物を用いてもよい。これらの特許に公表されてい る事稱は、引用により本明細書の内容となる。ポルフィ リン系化合物は、下記の構造式(!)で表されるものが

好ましい。 【0030】

> (化1) (I)

【0031】式中、Qは一N=又は一C(R)=であり、Mは金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物であり、Rは水素、アルキル、アラルキル、アリール又はアルケアリールであり、T'及びT'は、水素を表すか、いっしょになって不飽和6員環を形成するが、この不飽和6員環はアルキルかハロゲン等の置換基を含んでいて20 もよい。アルキル成分は炭素数が約1~6であることが好ましく、アリール成分はフエニルが好ましい。別の好ましい越接においては、ポルフィリン系化合物は、構造式(1)の色のとは、下式((1)に示すように金属原子が2つの水素原子でおきかわっている点で異なる。

[0032]

(H)

[化2]

【0033】 容用なポルフィリン系化合物の非常に好ましい例は、金属を含まないフタロシアニン類及び金属含有フタロシアニン類である。一般的にポルフィリン系化合物、特にフタロシアニン類は、いずれの金属を含省してもよく、この金属は2個以上の正の原子価を有することが好ましい。好ましい金属としては、例えば、コバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケル、そして特に網、鉛及び白金が維げられる。

【0034】 有用なポルフィリン系化合物の例を以下に 挙げる。

PC-1: ポルフィン

PC-2: 1、10、15、20―テトラフェニル―21H、23H-ポル

フィン錆(1()

PC-3: 1, 10, 15, 20一テトラフェニルー21H, 23H-ポル

フィン亜鉛(II)

PC-4: 5, 10, 15, 20-テトラキス (ペンタフルオロフェニル)

(6)

特剛平4-233194

21日、23日―ポルフィン

PC-5: シリコンフタロシアニンオキシド

**PC-6: アルミニウムフタロシアニンオキシド** 

PC-7: フタロシアニン(金属を含まない)

PC-8: ジリチウムフタロシアニン

PC-9: 銅デトラメチルフタロシアニン

PC-10: 鋼フタロシアニン

PC-11: クロムフタロシアニンフッ化物

PC-12: 亜鉛フタロシアニン

PC-13: 鉛フタロシアニン

PC-14: デタンフタロシアニンオキシド PC-15: マグネシウムフタロシアニン

PC-16: 銅オクタメチルフタロシアニン

【0035】有機EL装置の正孔輸送層は、少なくとも 一種の正孔輸送芳香族第三アミンを含有している。この 芳書族第三アミンは、炭素原子(そのうちの一つは芳書 深の深貫である)にのみ結合している少なくとも一個の 3個の窒素原子を含有する化合物である。一盤様におい ては、芳香族第三アミンは、モノアリールアミン、ジア リールアミン、トリアリールアミン又は高分子アリール *20* 原子、アリール基又はアルキル基を表すか、R!とR\* アミン等のアリールアミンでよい。低分子トリアリール アミンは、クラプフル等(Klupfeletal) に よる米国特許第3、180、730号に例示されてい る。ピニルかピニレンラジカルで置換されそして/又は 少なくとも一個の水素含有基を含有している他の適当な トリアリールアミンは、プラントレイ等(Brant1 ey et al) による米回特許第3,567,45 0号及び第3,658,520号に公表されている。好 ましい種類の芳香族第三アミンは、少なくとも二個のア ミン競分を含むものである。このような化合物として 30 は、以下の構造式 (1 1 1) で表されるものが挙げられ **5.** 

[0036]【他3】

(III)



【0037】式中、Q'及びQ'は、それぞれ独立して **芳香族第三アミン成分であり、Gは、アリーレン基、シ** クロアルキレン基、アルキレン基図は炭素一炭素糖合で 40 ある。構造式(111)を満足し、そして2個のトリア リール成分を含有する特に好ましい種類のトリアリール アミンは、以下の構造式(IV)を満足するものであ 3.

[0038]

(化4)

(IV)



【0039】式中、RI及びRIは、各々独立して水素 がいっしょになってシクロアルキル基を完成している原 子を表し、R® 及びR®は、各々独立して、下式(V) で示されるようなジアリール段換アミノ基で置換された アリール基を表す。

10

[0040]

[化5]

(V)

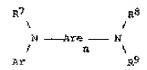


【0041】式中、R\* 及びR\* は、それぞれ独立して 選択されたアリール基である。別の好ましい強頼の芳香 放第三アミンは、テトラアリールジアミンである。テト ラアリールジアミンは、アリーレン基を介して結合した 式(V)で示されるようなジアリール基を2個含むこと が好ましい。好ましいテトラアリールジアミンとして は、下式(VI)により表されるものが難げられる。

[0042]

[4b6]

(VI)



【0043】式中、Areは、アリーレン基であり、n は、1~4の整数であり、Ar、R1、R1をびR • は、独立して選択されたアリール基である。

【0044】上記の機造式(HII)、(IV)、 50 (V) 及び (VI) の題々のアルキル、アルキレン、ア

リール及びアリーレン成分は、各々醫塾されていてもよ い。典型的な置換基としては、例えば、アルキル基、ア ルコキシ基、アリール基、アルコキシ基並びにフッ素、 塩素及び臭素等のハロゲンが挙げられる。種々のアルキ ル及びアルキレン成分は、典型的には、炭素数が約1~ 5 である。シクロアルキル成分の炭素数は3~約10で あるが、典型的には、5億、6個又は7個の環境素原子 を含み、例えば、シクロペンチル、シクロヘキシル及び、 シクロヘブチル環構造を有している。アリール及びアリ が好ましい。

【0045】有用な芳香族第三アミンの代表例が、バー ウイック等(Berwick etal)による米国特 許第4、175、960号やパン・スリケ等(Van Slyke et al) による米国特許第4,53 9,607号に公安されている。バーウイックは、さら に、有用な正礼輸送化合物として、上記で公表されたジ アリール及びトリアリールアミンの標ブリッジ密体とみ なすことができるN価趣カルバゾールを公表している。

たがって、上記した芳霄族第三アミンにおいて第三窒素 原子に直接結合した一個以上のアリール基を、少なくと、 も2個の縮合労香環を含有する芳香族成分に代えること により、短期間動作中と長期間動作中の両方のより高度 の有機EL装置安定性を達成することが可能である。短 期間 (0~50時間) 動作と長期間 (0~300 時 間)動作の安定が得られる最もよい組み合わせば、芳香 族第三アミンが(1)少なくとも2個の第三アミン成分 を含んでなり、そして(2)第三アミン窒素原子に結合 して少なくとも2個の縮合芳香族環を含有している芳香 族成分を含んでいるものである。以下に、少なくとも2

劉の紛合芳者族環と10~24個の環境素原子を含有す る芳香族化合物を例示する。

12

【0047】ナフタリン、アズレン、ヘブタレン、as ーインダセン、8ーインダセン、アセナフテレン、フェ ナレン、フェテントレン、アントラセン、フルオロアン ーレン成分は、フェニル及びフェニレン構造であること BB ストレン、アセフェテトリレン、アセアントリレン、ト リフェニレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、プレイ アデン、ビセン、ベリレン、ベンタフェン、ヘキサフェ ン、ルビセン、及びコロネン。

【0048】第三アミンの縮合芳香環成分は、約10~ 18種の環炭素原子を有することが好ましい。不飽和5 ~7員環を芳香6員環(即ち、ベンゼン環)と縮合して 省用な縮合芳香環域分を形成できるが、縮合芳香環域分 が少なくとも2個の縮合ベンゼン環を含むことが一般的 に好ましい。 2個の総合ベンゼン環を含有する総合芳香 【0046】上記したバンスリケ等(1))の教示にし 20 段成分の最も簡単な影繁は、ナフタリンである。したが って、好変しい芳智環成分はナフタリン成分であるが、 ナフタリン成分はナフタリン環構造を含有する全ての化 合物が含まれる。一価の形態では、ナフタリン成分は、 ナフチル成分であり、そして二価の形態では、ナフタリ ン成分はナフテレン成分である。

【0049】有用な芳香族第三アミンを以下に例示す

ATA-1: 1, 1ービス(4ージーp-トリルアミノフェニル)シクロへ キサン

ATA-2: 1, 1-ビス(4-ジーゥートリルアミノフェニル)ー4ーフ エニルシクロヘキサン

ATA-8: 4, 4'-ビス〈ジフェニルアミノ)カドリフェニル

ATA-4: ピス(4ーシメテルアミノー2ーメチルフェニル)フェニルメ タン

ATA-5: N, N, N-トリ (p-トリル) アミン

 $\mathsf{ATA} = \mathbf{6} : \quad \mathbf{4} = (\mathcal{Y} + \mathbf{p} + \mathbf{b} \mathcal{Y} \mathbf{F} \mathbf{S} \mathcal{I}) = \mathbf{4}^* = (\mathbf{4}^* + \mathbf{g} + \mathbf{p} + \mathbf{b} \mathcal{Y} \mathbf{F} \mathbf{S} \mathcal{I})$ アミノ) スチリル) スチルベン

ATA-7: N, N, N', N'  $-\overline{r}$   $\overline{r}$   $-\overline{r}$   $-\overline{r}$   $-\overline{r}$ ノビフェニル

ATA-8: N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノビ フェニル

ATA-9: Nーフェニルカルバゾール

ATA-10: ポリ (N-ビニルカルバゾール)

[0050]

ATA-11: 4, 4'-ビス (N-(1ーナフチル) -N-フェニルアミ **ノ〕ビフェニル** 

ATA-12: 4, 4" -ピス (N- (1ーナフチル) -N-フェニルアミ ノ〕 一p -ターフェエル

ATA-13: 4, 4'-ビス (N-(2-ナフチル) -N-フェニルアミ フ) ピフェニル

14

ATA-14: 4,4'-ピス [N-(3-アセナフテニル) -N-フェニ ルアミノ) ピフェニル

**ATA一15: 1,5-ビス〔N-(1一テフチル)一N一フェニルアミノ 〕 サフタリン** 

ATA-16: 4, 4'-ビス (N-(9ーアントリル) -N-フェニルア ミノ) ピフェニル

ATA-17: 4, 4" -ピス (N- (1-アントリル) -N-フェニルア ミノ) 一ゥーターフェニル

ATA-18: 4, 4'-ビス(N-2-フェナントリル)ーNーフェニル アミノ)ピフェニル

ATA-19: 4, 4'-ビス (N-(8-フルオランテニル) -N-フェ ニルアミノ) ピフェニル

ATA-20: 4,4'-ビス(N-(2-ピレエル)-Nーフェニルアミ **ノ)ビフェニル** 

[0051] ATA-21: 4, 4'-ピス [N-(2-ナフタセニル) -N-フェニル アミノ) ビフェニル

> ATA-22: 4,4'-ピス(N-(2-ベリレエル)-N-フェニルア ミノ) ピフェニル

> ATA-23: 4, 4'-ビス (N-(1-コロネニル) -N-フェニルア ミノ) ビフェニル

ATA-24: 2, 6ーピス (ジーpートリルアミノ) ナフタリン

ATA-25: 2, 6-ビス (ジー (1-ナフザル) アミノ) ナフタリン

ATA-26: 2,6-ビス (N-(1ーナフチル) -N-(2ーナフチル ) アミノ) ナフタリン

ATA-27: 4, 4"-ビス (N, N-ジ(2-ナフチル) アミノ) ター フェニル

ATA-28: 4, 4'ーピス {NーフェニルーNー [4ー (1ーナフチル **)フェニル)アミノ)ビフェニル** 

ATA-29: 4,4'-ビス(N-フェニルーN-(2-ピレニル)アミ フ〕ビフェニル

ATA-30: 2,6-ビス [N, N-ジ(2-ナフチル) アミン) フルオ レン

ATA-31: 4, 4" ービス (N, Nージーゥートリルアミノ) ターフェ

ATA-32: ピス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミン

【0052】カソードに隣接して海機エレクトロルミネー センス媒体の層を形成する際には、通常の電子注入・輸 送化合物(一種以上)を用いることができる。この層。 は、アントラセン、ナフタリン、フェナントレン、ピレー レクトロルミネセンス紛料並びにガーニー等(Gurn ee et al) による米国特許第3, 172, 86 2号、ガーニーによる米国特許第3,173,050 号、ドレスナー(Dresner)、「アントラセンに おける二重注入エレクトロルミネセンス(Double) Injection Electrolumines cence)」、アールシーエイ・レビュー(RCA) <u>Review</u>)、第30巻、322~334 (196 9) 及びドレスナーはよる米国特許第3,710,16

する他の箱合環ルミネセンス材料により形成できる。電 子注入・輸送帯域化合物のうち、薄膜を形成するのに有 - 用なものは、上記したタングによる米園特許第4,35 6,429号に公表されている!,4―ジフェニルブタ ン、クリセン、ペリレン等の従来から概示されているエー*40*ージエン及びテトラフェニルプタジエン等のブタジエン 類:クマリン類:並びにトランススチルベン等のスチル ベン類である。カソードに隣接する層を形成するのに使 用することができるさらに他の薄膜形成電子注入・輸送 帯域化合物は、螢光増白剤、特に上記したバンスリケ等 による米国特許第4,539,507号に開示されてい るものである。宵用な盪光増白剤としては、例えば、精 | 造式(V 1 1 )及び(V 1 ( 1 ) を満足するものが挙げ られる。

[0053]

7号に例示されているような約8個以下の縮合環を含有 50 【化7】

(9)

特開平4-233194

15 (VII)

【0054】又該 [0055] [化8] (VIII)

【0056】式中、R'、R'、R'及びR'は、それ ぞれ独立して水素;炭素数が1~10の飽和脂肪装炭化 水素、例えば、プロピル、t-プチル、ヘプチル等;炭 素数が6~10のアリール、例えば、フェナントレン及 ぴナフチル;又はクロロ、フルオロ等のハロ;又はR1 とR®又はR®とR\*は、いっしょに、必要に応じてメ チル、エチル、プロピル等の炭素数1~10の少なくと。 も一個の飽和脂肪族炭化水素を有する縮合芳香環を完成 するのに必要な原子を構成し:

【0057】R<sup>5</sup> は、メチル、エチル、n-エイコシル 等の炭素数1~20の飽和脂肪族換化水素:炭素数6~ 10のアリール、例えば、フェニル及びナフチル:カル ボキシル;水素;シアノ;又はハロ、例えば、クロロ、 フルオロ等であるが、個し、式(VII)においては、 R®、R®及びR®のうちの少なくとも2つは、検索数 3~10の飽和脂肪族炭化水素、例えば、プロビル、ブ チル、ヘプチル等であり;

**2は、一○一、一NH―又は一S―であり;そして** Yit,  $-R^6 - (CH = CH -) R^6 -$ , [0058]

[469]

[0059] -cH=cH- $- (CH = CH -) R^{\circ} - (CH = CH -)$ 

(IX)

【0068】式中、Meは、金属を表し; aは、1~3 の整数であり;そして2は、各々独立して少なくとも2 御の締合芳香環を省する紋を完成している原子を衰す。 【0069】上記のことから明らかなように、金属は、

一個、二個又は三個の金属である。金属は、例えば、リ チウム、ナトリウム若しくはカリウム等のアルカリ金 属:マグネシウム着しくはカルシウム等のアルカリ土類 50 会属:又は翻索着しくはアルミニウム等の主類金属であ

\* [0060] 【化10】

18

[0061] 又は [0062][化11]

$$\langle \ell_z \rangle$$

【0063】 (武中、mは、0~4の整数であり; n は、農業数6~10のアリーレン、例えば、フェニレン 及びナフチレンであり:そして2'及び2"は、名々数 立してN又はCHである)を表す。

【0064】本明細書で使用されている用語「脂肪族炭 化水素(aliphatic)」には、未置換脂肪族炎 化水素だけでなく置換脂肪族炭化水素も含まれる。置換 脂肪族炭化水素の場合における鼠換基としては、例え - 20 - ほ、炭素数 1 ~ 5 のアルキル、例えば、メチル、エチ ル、プロピル等:炭素数6~10のアリール、例えば、 フェニル及びナフチル;クロロ、フルオロ等のハロ:ニ トロ:及び蕨梁数1~5のアルコキシ、例えば、メトキ シ、エトキシ、プロポキシ等が挙げられる。

【0085】有用であるさらに他の盤光増白剤は、19 ? 1 年発行の「ケミストリー・オブ・シンセティック・ ダイズ (Chemistry of Syntheti cDyes) の第5巻の第618~637頁及び第64 0 頁に列挙されている。まだ薄膜形成性となっていない 30 ものは、脂肪族炭化水素成分を一方又は両方の未給環に 結合させることにより薄膜形成性とすることができる。

【0066】本発明の布機EL装置の電子注入・輸送層 の形成に使用するのに特に好ましいものは、オキシンの キレート(一般的に「8-キノリノール」又は「8-ヒ ドロキシキノリン」とも称する)をはじめとする金属キ レートオキシノイド化合物である。このような化合物 は、両方とも性能が高レベルであり、そして容易に薄膜 に作製できる。使用できるオキシノイド化合物として、 以下の精造式(IX)を満足するものが挙げられる。

[0067] [化12]

ることができる。一般的には、有用なネレート金属であ ることが知られている一個、二価叉は三個の金属を頂い ることができる。

【0070】 乙は、少なくとも2個の縮合芳香環《少な くとも1個はアゾール又はアジン類である)を含有する。 複素類核である。必要に応じて、脂肪族環と芳香環の闘★ ま方を含めたさらなる環を、2個の必要な環と縮合でき る。機能を向上することなく分子の癌が増加するのを避 **けるために、深原子の数は、18個以下に維持すること** が好ましい。

18

【0071】有用なキレートオキシノイド化合物を以下 に例示する。

CO-1: アルミニウムトリソキシン

〔トリス(8―キノリノール)アルミニウムとも称される〕

CO-2: マグネシウムビオキシン

【ビス(8一キノリノール)マグネシウムとも称される〕

CO-3: ピス [ベンゾ (f) -8-キノリノール] 亜鉛

CO-4: アルミニウムトリス(5-メデルオキシン)

(トリス (6-メテルー8-キノリノール) アルミニウムとも称 される)

CO-5: インジウムトリソキシン

【トリス(8一キノリノール)インジウムとも称される)

CO-6: リチウムオキシン

[8-キノリノールリチウムとも称される]

CO-7: ガリウムトリス(3-クロロオキシン)

[トリス (5一クロロー8一キノリノール) ガリウムとも称され

CO-8: DNDDAUX (5-DDDDAFDD)

〔ビス(5一クロロー8一キノリノール)カルシウムとも称され

C○-9: ポリ〔亜鉛(II)―ビス(8―ヒドロキシ―5―キノリニル)

メタン〕

CO-10: ジリチウムエピンドリジオン

【0072】本発明の有機EL装置においては、有機ル ミネセンス媒体の総厚さを14日(10,000オング 極間電圧を用いながら、効率的な発光と両立する電流密 度を維持することが可能である。1 4 m 未満の厚さで、 20ポルトの電圧を印加すると、2×10°ポルト/c 血を超えるフィールドポテンシャルが得られ、これは、 効率的な発光と両立する。有機ルミネセンス媒体の厚さ が一桁減少(0.1μω、即ち、1000オングストロ 一厶に減少)すると、印加電圧を更に減少で多及び/又 はフィールドポテンシャルをさらに増加できるので、電 流密度は、十分に該置精造の他力範囲内である。

は、有機已し装置の電気的パイアスで電極が短絡するの。 を防止するために絶縁バリヤーを提供することである。 ただ一つのピンホールが有機エレクトロルミネセンス媒 体を通って延びても、短絡が生じる。例えば、アントラ セン等の単一の高結晶健ルミネセンス材料を用いた従来 の有機EL装置とは異なり、本発明のEL装置は、気熱 なしに、有機ルミネセンス媒体の総厚さが極めて小さい。 状態に作製できる。この理由の一つは、3層に重量した。 國が存在するので、電極間に伝導路を形成するように祭

からである。このことにより、有機ルミネセンス媒体の 層のうちの一層又は2層でさえも、許容できるEL装置 ストローム)未満に限定することにより、比較的低い電 50 の性能と信頼性を保持しながら、コーティングでフィル ムを形成するには連想的でない材料から形成できる。

【0074】有機エレクトロルミネセンス媒体を形成す るのに好ましい材料は、葬職の形態に作製できるもの、 即ち、厚さが 0. δ μπ (δ 0 0 0 オングストローム) 未満の連続層の形態に作製できるものである。有機ルミ キセンス媒体の一層以上の層を溶媒盤布するときには、 **被膜形成性高分子パインダーを活物質とともに共堆積し** て、ピンホール等の構造欠陥のない連続層を確実に形成 することができる。もしパインダーを用いるならば、パ 【0073】有機ルミネセンス媒体が行う機能の一つ 40 インダーは、それ自体、高絶繰耐力、好ましくは少なく とも約2×10° ボルト/cmを示さなければならない ことは言うまでもない。多種多様な既知の溶液流延付加 及び縮合重合体から適当なポリマーを選ぶことができ る。適当な付加重合体を例示すると、スチレン、モーブ チルスチレン、N = ピニルカルパゾール、ピニルトルエ ン、メデルメタクリレート、メデルアクリレート、アク リロニトリル及びビニルアセテートのの重合体及び共重 合体(ターボリマーも含む)が挙げられる。適当な癒合 重合体を例示すると、ポリエステル、ポリカーポネー 列されている層にピンホールが生じる可能性が減少する 50 ト、ボリイミド及びポリスルホンが挙げられる。衝物質

が不必要に潜釈されるのを避けるために、バインダー は、層を形成する材料の総型量に対して50重量光末摘 に限定することが好ましい。

【0075】有機エレクトロルミネセンス媒体を形成す る活物質は、薄膜形成锉材料であるとともに真空熱着で きるものが好ましい。真空繁羞では、蔥めて薄く欠陥の ない連続層が形成できる。具体的には、十分なEL装置 **性能を維持しながら、個々の層を約50オングストロー** ムと非常に薄くすることができる。真空薫着ポルフィリ アミンを正孔輸送圏として用い、そしてキレートオキシ ノイド化合物を電子強入・輸送層として用いるとき、約 50~5000オングストロームの範囲の厚さが可能で あるが、層厚さは、100~2000オングストローム が好ましい。有機ルミネセンス媒体の総厚さは、少なく とも約1000オングストロームが好ましい。

#### [0076]

【実施例】本発明とその利点を、以下具体的実施例によ りさらに説明する。用語「原子%(atomic pe r c e n t )」は、金属原子の存在総数に対する特定の 20 せるのには効果がないことを示している。 金属の存在百分率を示す。換官すれば、モル%に類似し ているが、モル基準ではなく原予基準である。実施例で 用いられる用語「セル(cell)」とは、有機EU装 置を意味する。接尾許凡を付けた数の実施例は、本発明 の実施態概を表し、一方、接尾辞口を付けた数の実施例 は、バリエーションの比較のためにもうけたものであ

【0077】実施例1C:アルミニウムキャップ層3層 有機ルミネセンス媒体を有する有機EL装置を以下の方 法で作製した。

- a) 酸化インジウム錫盤布ガラスからなる透明アノード を、0.05mmアルミナ網磨剤を用いて数分間研磨 後、イソプロピルアルコールと蒸留水の1:1(容積) 混合物中で超音波維浄を行った。イソプロピルアルコー ルですすいだ後、トルエンベーパー中に約5分間浸漬し to.
- b) 正孔注入PC-10 (350オングストローム) 層 **をアノード上に真空蒸着した。PC−10は、タングス** テンフィラメントを用いた石英ポートから蒸発させた。 【0073】c)次に、正孔輸送ATA-1(330才 40 ングストローム)層を、PC-10層の上に蒸着した。 ATA-1も、タングステンフィラメントを用いた石英 ボートから蒸発させた。
- d) 次に、電子注入・輸送CO-1 (600オングスト ローム) 層を、ATA-1層上に素着した。CO-1 も、タングステンフィラメントを用いた石英ポートから 熱発させた。
- e) CO-1層上に、10:1の容績比のMgとAIか ら形成した250オングストロームの注入層と、200 0オングストロームのA1キャップ層とからなるカソー 50 面積の38.5%がダークスポットで占められていた。

ドを蒸着した。

【0079】ガラスカバーをカソード上に配置し、そし てノーランド (商標) 60(Norland 60)光 学接着剤をセルの問題に塗布して、アノードを担持して いるガラス支持体をガラスカバーに接着することによ り、セルをカプセル化した。作製直後に動作させたとき に、セルはダークスポットを示さなかった(鬩ち、発光 はアノード表面全体にわたって均一であった)。周囲研 究室状態下(標準温度及び圧力又はそれに近い温度又は ン化合物を正孔注入層として用い、幾膜形成勞香製第三 30 圧力で、湿度は気候状態で変化させた状態)で70日間 保存後にセルを動作させたところ、最初に発光のあった。 総面積の約25%がダークスポットにより占められた。

20

【0080】実施例20:有機採護層セルをガプセル化 する前に、CO-1からなる2000オングストローム の保護圏をカソード上に真空蒸着した以外は、実施例1 Cを反復した。実施例1Cと同一の条件で70日間保存 後には、初期発光面積に対して実施例10とほぼ間じ割 合がダークスポットにより占められた。このことは、有 機材料CO-1自体は、ダークスポットの形成を減少さ

【0081】実施例30:厚さを増大したアルミニウム 保護層セルをカプセル化する前に、アルミニウムからな るさらに2000オングストロームの保護層をカソード 上に真空蒸着した以外は、実施例10を反復した。即 ち、Mg:A1電子注入層上に合計4000オングスト ロームのアルミニウムを蒸着した。実施例1Cと同一の 条件で70日間保存後には、初期発光面積に対して実施 例10とほぼ同じ割合がダークスポットにより占められ た。このことは、迪加のアルミニウム自体は、ダークス ポットの形成を減少させるのには効果がないことを示し でいる。

【0082】 実施例4C:奪機保護層をオーバーコート <u>したアルミニウムキャップ層</u>セルをカプセル化する前 に、アルミニウムからなる1000オングストロームの 保護層をカソード上に真空蒸着(キャップ層を含めて合 計3000オングストローム)した後、CC-1からな る1000オングストロームの保護層を真空機着した以 外は、実施例1Cを反復した。実施例1Cと同一の条件 で70日間保存後には、初期発光面積に対して実施例1 Cと確認同じ割合がダークスポットにより占められた。 このことは、金属保護層と有機材料保護層とを重量して **組み合わせたものは、ダークスポットの形成を減少させ** るのには効果がないことを示している。

【0083】<u>実施例もで</u>:<u>無キャップ層</u>カソードのM g:Ag電子注入層上にアルミニウムキャップ層を形成 しない以外は、実施例10と間様にセルを構成した。セ ルを作製直後に動作させたときに、ダークスポットを示 さなかった。75℃、45%相対温度で300時間でル を保存した後に動作したところ、最初に発光のあった総 (12)

特開平4-233194

【0084】<u>実施例6日:カルシウムキャップ層</u>カソー ド電子注入層上に2000オングストロームのカルシウ ムカソードキャップ層を真空蒸着する以外は実施例5 C と同様にセルを作製して試験した。作製直後のセルの動 作は、ダーケスポットを示さず、300時間保存後のセ ルの動作も見立ったダークスポットを示さなかった。

#### [0085]

【発明の効果】カゾードの電子注入層より低い仕事関数 を有するキャップ層で構成する有機EL装置は、装置の 長時間動作を通してダークスポットの出現が客しく低減 30 116…接合 することを示した。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による有機EL装置の観路図である。個 々の層の厚さが非常に薄く、そして種々の要素の厚さの 差が非常に大きいために、スケールにあわせて描いた り、都合のよい比例スケールとすることができないの。 で、図面ではやむを得ず概略的に示している。

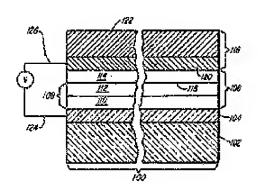
#### 【符号の説明】

- 100…EL装置
- 102…透過性基板
- 104…透過往アノード
- 106…有機エレクトロルミネセンス媒体

22

- 108…正孔注入・輸送帯域
- 110…正孔注入層
- 112…正孔翰送層
- 114…電子注入・輸送帯域
- - 118…カソード
  - 120…電子差入階
  - 122…キャップ層
  - 124…讓休
  - 126…導体
  - V…我源

图1]



フロントページの続き

CO9K 11/06

(51) Int. Cl. 8

識別記号 庁内整理番号 Z 6917-4H

FΙ

技術表示箇所